

# 2SD425, 2SD426

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ  
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

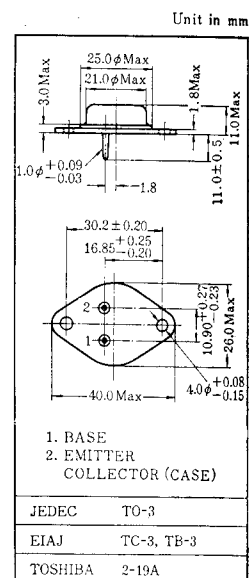
## ○電力増幅用

### ○ Power Amplifier Applications

- コレクタ損失が大きい. :  $P_C=100W$ (2SD425, 2SD426)
- 高耐圧です.  $V_{CE0}=140V$ (2SD425)  
 $V_{CE0}=120V$ (2SD426)
- 2SB555, 2SB556 とコンプリメンタリになります.
- 大電力Hi-Fiオーディオアンプ出力段に最適です.  
:  $P_o=80W$ (2SD425)  
:  $P_o=60W$ (2SD426)
- Complementary to 2SB555, and 2SB556
- Recommended for High-Power High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

### 最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ C$ )

| Characteristic             | Symbol    | Rating  | Unit       |
|----------------------------|-----------|---------|------------|
| コレクタ・ベース間電圧                | 2SD425    | 140     | V          |
|                            | 2SD426    | 120     |            |
| コレクタ・エミッタ間電圧               | 2SD425    | 140     | V          |
|                            | 2SD426    | 120     |            |
| エミッタ・ベース間電圧                | $V_{EBO}$ | 5       | V          |
| コレクタ電流                     | $I_C$     | 12      | A          |
| エミッタ電流                     | $I_E$     | -12     | A          |
| コレクタ損失( $T_c=25^\circ C$ ) | $P_C$     | 100     | W          |
| 接合温度                       | $T_j$     | 150     | $^\circ C$ |
| 保存温度                       | $T_{stg}$ | -65~150 | $^\circ C$ |



アクセサリはAC73を適用  
MOUNTING KIT NO. AC73

### 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ C$ )

| Characteristic | Symbol        | Condition                   | Min.               | Typ. | Max. | Unit    |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------|------|------|---------|
| コレクタシャ断電流      | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=60V, I_E=0$         | —                  | —    | 100  | $\mu A$ |
| エミッタシャ断電流      | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=5V, I_C=0$          | —                  | —    | 100  | $\mu A$ |
| コレクタ・エミッタ間降伏電圧 | 2SD425        | $I_C=0.1A, I_B=0$           | 140                | —    | —    | V       |
|                | 2SD426        |                             | 120                | —    | —    | V       |
| エミッタ・ベース間降伏電圧  | $V_{(BR)EBO}$ | $I_E=10mA, I_C=0$           | 5                  | —    | —    | V       |
| 直流電流増幅率 (Note) | $h_{FE}$      | $V_{CE}=5V, I_C=2A$         | 40                 | —    | 140  |         |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | 2SD425        | $I_C=7A, I_B=0.7A$          | —                  | —    | 3.0  | V       |
|                | 2SD426        |                             | $I_C=6A, I_B=0.6A$ | —    | —    | 3.0     |
| ベース・エミッタ間電圧    | $V_{BE}$      | $V_{CE}=5V, I_C=7A$         | —                  | —    | 2.5  | V       |
| トランジション周波数     | $f_T$         | $V_{CE}=5V, I_E=-2A$        | —                  | 6    | —    | MHz     |
| コレクタ出力容量       | $C_{ob}$      | $V_{CE}=10V, I_E=0, f=1MHz$ | —                  | 330  | —    | pF      |

Note ;  $h_{FE}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE}$ , the 2SD425 and 2SD426 are classified as follows.

| Classification | Min. | Max. |
|----------------|------|------|
| 2SD425—R       | 40   | 80   |
| 2SD426—R       |      |      |
| 2SD425—O       | 70   | 140  |
| 2SD426—O       |      |      |